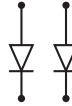


BAS28

**SURFACE MOUNT
DUAL, ISOLATED HIGH SPEED
SILICON SWITCHING DIODES**



SOT-143 CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR BAS28 consists of two electrically isolated ultra-high speed silicon switching diodes manufactured by the epitaxial planar process and packaged in an epoxy molded SOT-143 surface mount case. This device is designed for high speed switching applications.

MARKING CODE: A61 or JTW

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Continuous Reverse Voltage
Peak Repetitive Reverse Voltage
Continuous Forward Current
Peak Repetitive Forward Current
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\mu\text{s}$
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{ms}$
Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{s}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_R 75
 V_{RRM} 85
 I_F 250
 I_{FRM} 500
 I_{FSM} 4.0
 I_{FSM} 2.0
 I_{FSM} 1.0
 P_D 350
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 θ_{JA} 357

UNITS

V
V
mA
mA
A
A
A
mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_R	$V_R=25\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$		30	μA
I_R	$V_R=75\text{V}$		1.0	μA
I_R	$V_R=75\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$		50	μA
V_F	$I_F=1.0\text{mA}$		715	mV
V_F	$I_F=10\text{mA}$		855	mV
V_F	$I_F=50\text{mA}$		1.00	V
V_F	$I_F=150\text{mA}$		1.25	V
C_T	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$		2.0	pF
t_{rr}	$I_F=I_R=10\text{mA}, I_{rr}=1.0\text{mA}, R_L=100\Omega$		6.0	ns
Q_s	$I_F=10\text{mA}, V_R=5.0\text{V}, R_L=500\Omega$		45	pC
V_{FR}	$I_F=10\text{mA}, t_r=20\text{ns}$		1.75	V

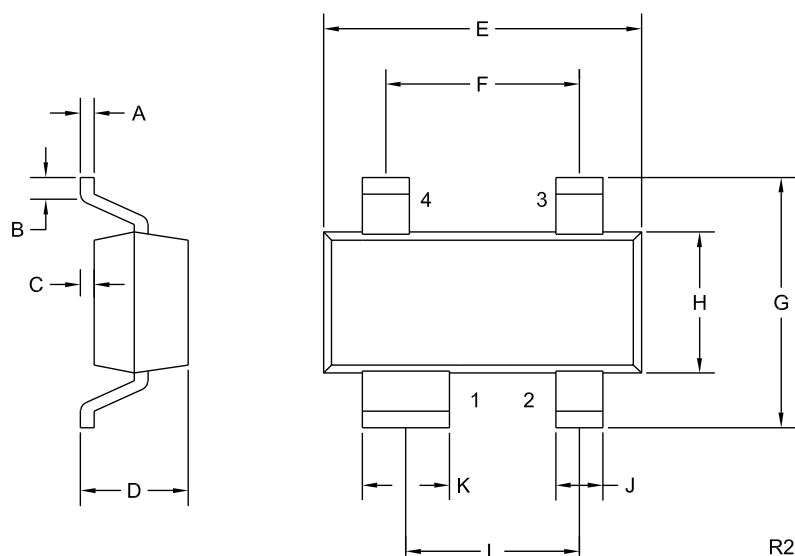
R7 (20-October 2010)

BAS28

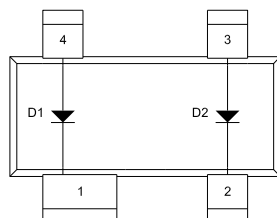
SURFACE MOUNT
DUAL, ISOLATED HIGH SPEED
SILICON SWITCHING DIODES



SOT-143 CASE - MECHANICAL OUTLINE



PIN CONFIGURATION



LEAD CODE:

- 1) CATHODE D1
- 2) CATHODE D2
- 3) ANODE D2
- 4) ANODE D1

MARKING CODE: A61 or JTW

SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.006	0.08	0.15
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	-	0.045	-	1.14
E	0.110	0.120	2.79	3.04
F	0.075		1.90	
G	-	0.098	-	2.50
H	0.047	0.055	1.19	1.40
J	0.014	0.020	0.36	0.50
K	0.030	0.037	0.76	0.93
L	0.067		1.70	

SOT-143 (REV: R2)

R7 (20-October 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9